

产品特性:

工作频率: 2.7~3.5GHz

饱和输出功率: $P_{\text{sat}} \geq 50\text{dBm}$

功率增益: $\text{Gain} \geq 11\text{dB}$

附加效率: $\text{PAE} \geq 48\%$

端口匹配: $Z_{\text{in}}/Z_{\text{out}} = 50\Omega$

产品说明:

HXN40035是一款氮化镓内匹配功率管,采用先进的平面内匹配合成技术和成熟的薄膜混合集成工艺,产品的典型工作频带为2.7~3.5GHz,具有高功率、高效率及温度等环境适应性等特点,能够广泛应用于各种射频/微波系统中。

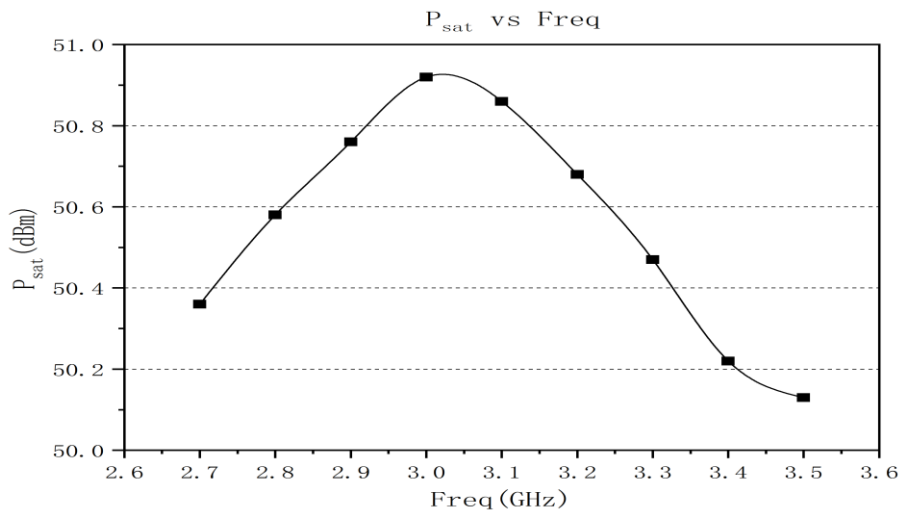
最大额定值 ($T_c=25^\circ\text{C}$, 不推荐在此条件下使用):

参数	符号	值	单位
漏源电压	V_{DS}	40	V
栅源电压	V_{GS}	-5	V
存储温度	T_{stg}	-65 to +175	$^\circ\text{C}$
沟道温度	T_{ch}	175	$^\circ\text{C}$

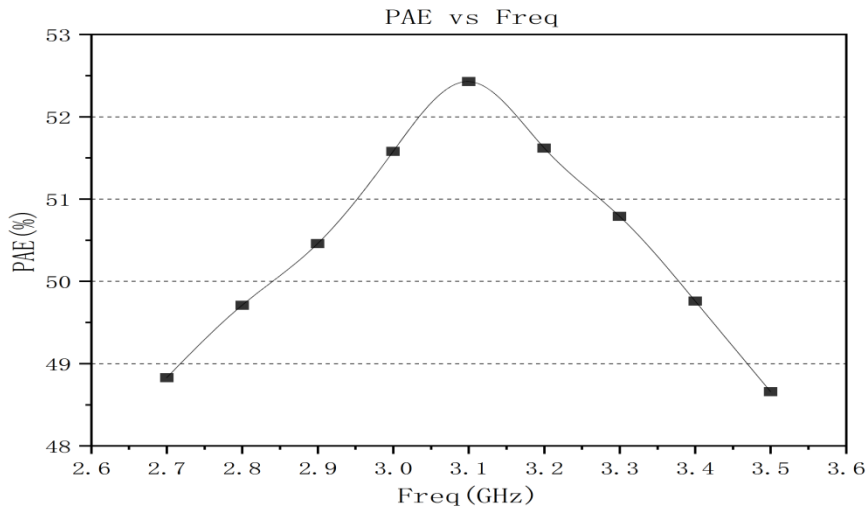
微波电性能:

参数	符号	测试条件	值			单位
			Min	Typ	Max	
漏极电流	I_{dsr}	$V_{DS}=28V$	-	6.6	-	A
饱和输出功率	P_{sat}	脉冲工作	50	-	-	dBm
功率增益	G_p	$T=1ms, Duty=10\%$	11	-	-	dB
附加效率	PAE	$P_{in}: 39dBm$	48	-	-	%
增益平坦度	ΔG	Freq: 2.7~3.5GHz	-0.8	-	+0.8	dB

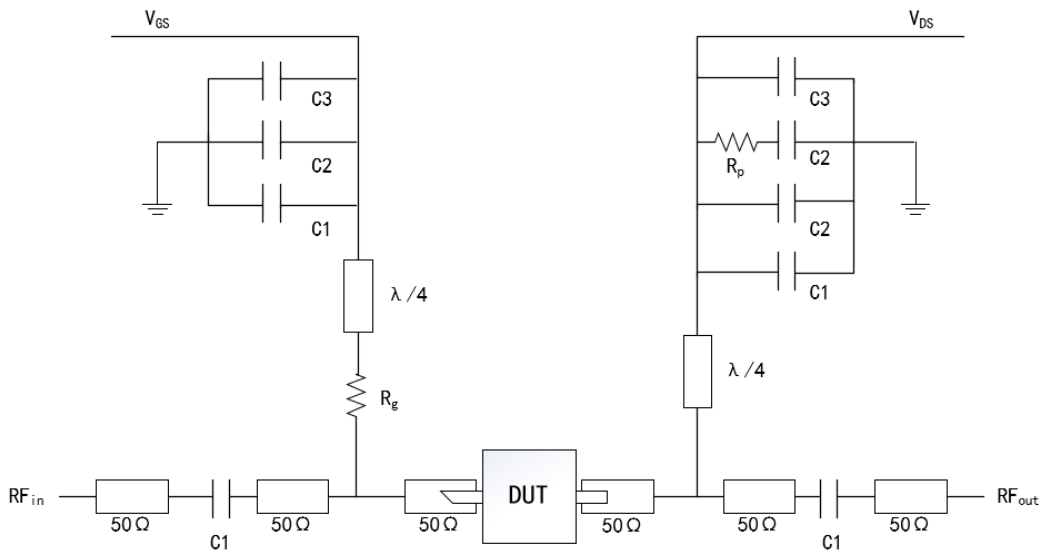
典型曲线:



2.7-3.5 GHz GaN Internally-matched Power Transistor



推荐应用电路:



DUT: 待测器件

C1: 8pF

R_p : 51Ω

C2: 1000pF

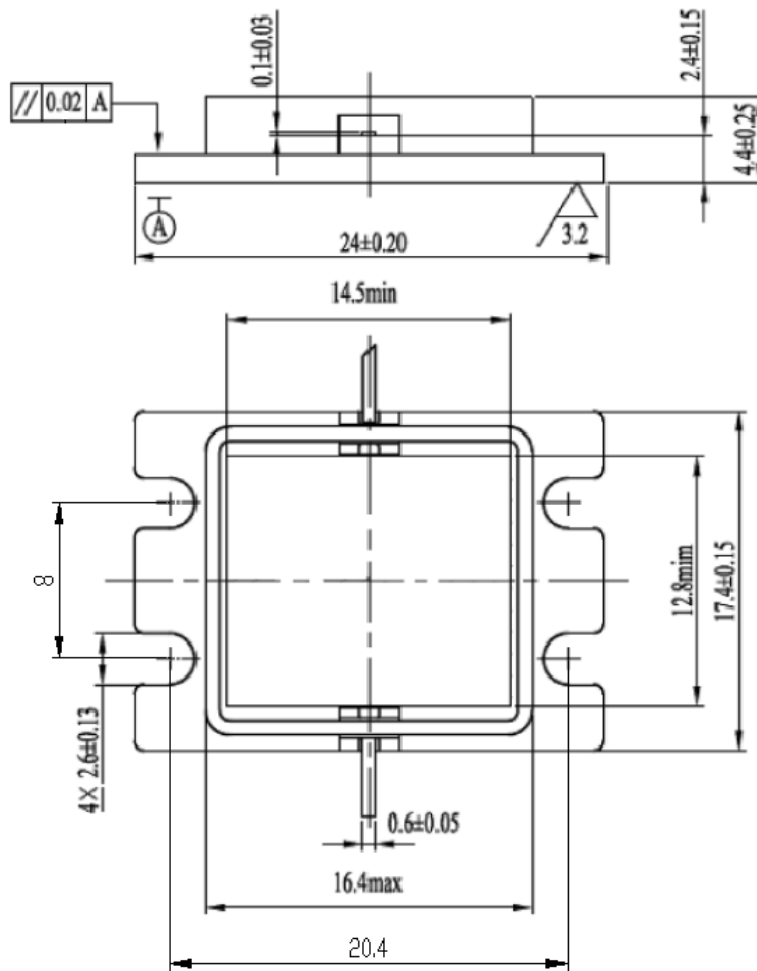
R_G : 15Ω

C3: 100uF

防静电等级:

ESD	Class III	2000V
-----	-----------	-------

外观尺寸:



使用注意事项:

- 运输存储过程中注意干燥。
- 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯。
- 加电时先加栅电再加漏电。